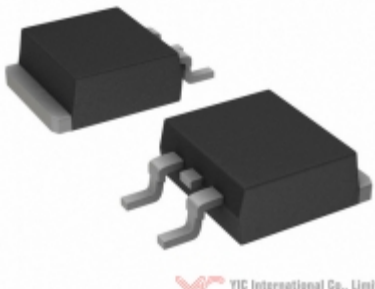






	<h2 style="color: red;">FQB8P10TM</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQB8P10TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 100V 8A D2PAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FQB8P10TM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 33814 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQB8P10TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 8A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33814 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 8A (Tc) 3.75W (Ta), 65W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 65W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	530 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	470pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQB8P10TMCT

FQB8P10TM ist neu im Original, Suche FQB8P10TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB8P10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB8P10TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB8P10TM-NL VB FQB8P10TM-NL VB</p>	 <p>FQB9N08 Fairchild/ON Semiconductor FQB9N08 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB8N90CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.3A D2PAK</p>	 <p>FQB8P10 FAIRCHI FQB8P10 FAIRCHI</p>
 <p>FQB8N90CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6.3A D2PAK</p>	 <p>FQB8P10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 8A D2PAK</p>	 <p>FQB8N80 Fairchild/ON Semiconductor FQB8N80 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB9N08L VB FQB9N08L VB</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQB6N70TM	↔ FQB6N90TM	⇒ FQB6N90TM_AM002	D FQB6N90TM_AM002	↔ FQB7042FB
⊣ FQB7045FB	⊛ FQB70N03	D FQB70N06	⇒ FQB70N08	↔ FQB70N10TM
⊛ FQB7N10L	⊣ FQB7N20L	⊛ FQB7N60TM	↔ FQB7N60TM	↔ FQB7N65C
D FQB7N65CTM	⊛ FQB7N65CTM	⊣ FQB7P20TM	⊛ FQB7P20TM	↔ FQB85N06
⇒ FQB85N06TM	↔ FQB8N25TM	⊛ FQB8N25TM	⊣ FQB8N60C	↔ FQB8N60CFTM
↔ FQB8N60CFTM	⇒ FQB8N60CTM	D FQB8N60CTM	⊛ FQB8N60TM	⊣ FQB8N90CTM
⊛ FQB8N90CTM	D FQB8P10TM	⇒ FQB8P10TM-NL	↔ FQB9N08L	↔ FQB9N08LTM
⊣ FQB9N08LTM	⊛ FQB9N25C	↔ FQB9N25CTM	⇒ FQB9N25CTM	↔ FQB9N25TM
⊛ FQB9N25TM	⊣ FQB9N50C	⊛ FQB9N50CFTM	D FQB9N50CFTM	↔ FQB9N50CTM
↔ FQB9N50CTM	⊛ FQB9N50TM	⊣ FQB9N50TM	⊛ FQB9P25TM	↔ FQB9P25TM

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

